

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 16 年 8 月 12 日 (2004.8.12)

【公開番号】特開 2002-343842 (P2002-343842A)

【公開日】平成 14 年 11 月 29 日 (2002.11.29)

【出願番号】特願 2001-215657 (P2001-215657)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/66

G 0 1 B 11/06

H 0 1 L 21/304

H 0 1 L 27/12

【F I】

H 0 1 L 21/66 P

G 0 1 B 11/06 Z

H 0 1 L 21/304 6 2 2 S

H 0 1 L 27/12 B

H 0 1 L 27/12 T

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 7 月 24 日 (2003.7.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記解析波長領域を設定する工程では、

前記酸化膜の屈折率を n_{ox} 、膜厚を d_{ox} とし、 m を任意の正数であるとする、前記解析波長領域を示すとして、

【数 1】

$$\frac{2 \cdot n_{ox} \cdot d_{ox}}{m - 0.98} > \lambda > \frac{2 \cdot n_{ox} \cdot d_{ox}}{m - 0.02}$$

を満たす範囲に設定することを特徴とする請求項 1 に記載の半導体層の膜厚測定方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0056

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0056】

【数 13】

$$\frac{2 \cdot n_{ox} \cdot d_{ox}}{m - 0.98} > \lambda > \frac{2 \cdot n_{ox} \cdot d_{ox}}{m - 0.02}$$